
	<h2>SIHP14N50D-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIHP14N50D-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 14A TO-200AB</p> <p>Datenblätter: 1.SIHP14N50D-E3.pdf 2.SIHP14N50D-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIHP14N50D-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 14A TO-200AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	400 mOhm @ 7A, 10V
Verlustleistung (max)	208W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Andere Namen	SIHP14N50DE3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	15 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1144pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	58nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 14A (Tc) 208W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	14A (Tc)

SIHP14N50D-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHP14N50D-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHP14N50D-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SIHP14N50D-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIHP12N65E VB SIHP12N65E VB</p>	 <p>SIHP12N65E-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 650V 12A TO-220AB</p>	 <p>SIHP12N65E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 650V 12A TO-220AB</p>	 <p>SIHP14N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 13A TO220AB</p>
 <p>SIHP14N50D-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 500V 14A TO-200AB</p>	 <p>SIHP14N50D-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 14A TO-200AB</p>	 <p>SIHP14N60E-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 13A TO220AB</p>	 <p>SIHP14N50D-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 500V 14A TO-200AB</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIHP14N50D-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIHP14N50D-E3 Datenblatt	SIHP14N50D-E3-Datenblätter	SIHP14N50D-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIHP14N50D-E3
SIHP14N50D-E3 Electronic	SIHP14N50D-E3-Komponenten	SIHP14N50D-E3-Verteiler	SIHP14N50D-E3-Bild	SIHP14N50D-E3-Teil
SIHP14N50D-E3 Preis	SIHP14N50D-E3 Hersteller	SIHP14N50D-E3 Bild	SIHP14N50D-E3 Aktie	SIHP14N50D-E3 Inventar
SIHP14N50D-E3 Neu	SIHP14N50D-E3 Original	SIHP14N50D-E3 garantiert	SIHP14N50D-E3 RFQ	SIHP14N50D-E3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited